



SG-215

SG-215は、高出力赤外発光ダイオードと、高感度フォトトランジスタを組み合わせた透過型フォトインタラプタです。高精度位置検出に適した、汎用インタラプタです。

The SG-215 photointerrupter high-performance standard type, combines high-output GaAs IRED with high sensitive phototransistor.

特長 FEATURES

- 高精度位置検出
- 高速応答
- 受発光間ギャップが広い。
- 広範囲への応用が可能。

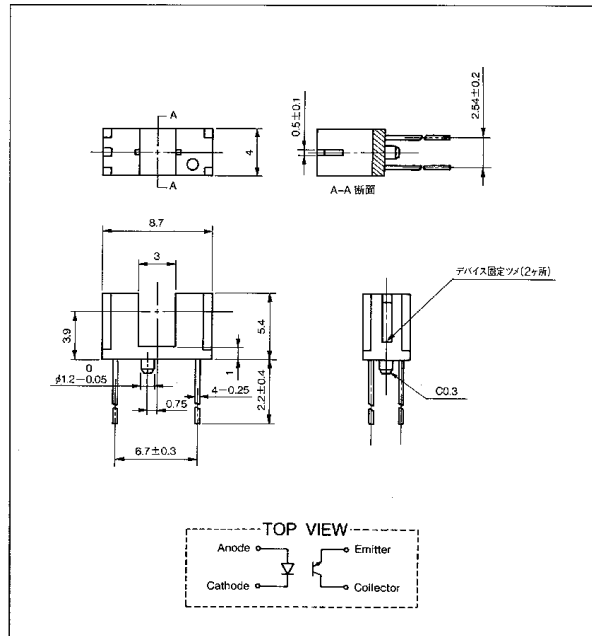
- High performance
- High-speed response
- 5mm gap.
- Widely applicable

用途 APPLICATIONS

- テープエンド・センサ
- タイミング・センサ
- エッジ・センサ
- 複写機

- Tape-end sensors
- Timing sensors
- Edge sensors
- Copiers

外形寸法 DIMENSIONS (Unit:mm)



最大定格 MAXIMUM RATINGS

(Ta=25℃)

Item		Symbol	Rating	Unit
入 力 Input	許 容 損 失 Power dissipation	P _D	75	mW
	逆 電 圧 Reverse voltage	V _R	5	V
	順 電 流 Forward current	I _F	50	mA
	パルス順電流 Pulse forward current ^{*1}	I _{FP}	1	A
出 力 Output	コレクタ損失 Collector power dissipation	P _C	75	mW
	コレクタ電流 Collector current	I _C	20	mA
	コレクタ・エミッタ間電圧 C-E voltage	V _{CEO}	30	V
	エミッタ・コレクタ間電圧 E-C voltage	V _{ECO}	5	V
動 作 温 度 Operating temp.		T _{opr.}	-20~+75	℃
保 存 温 度 Storage temp.		T _{stg.}	-40~+75	℃
半田付温度 Soldering temp. ^{*2}		T _{sol.}	240	℃

*1 $t_w=100\mu\text{sec.}$ 、 $T=10\text{msec.}$

*2 リード根元より2mm離れた所で、 $t=5\text{sec.}$

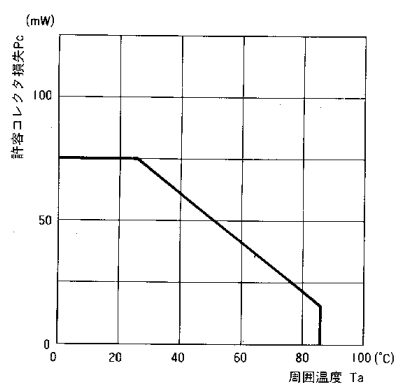
(Ta=25℃)

電気的光学的特性

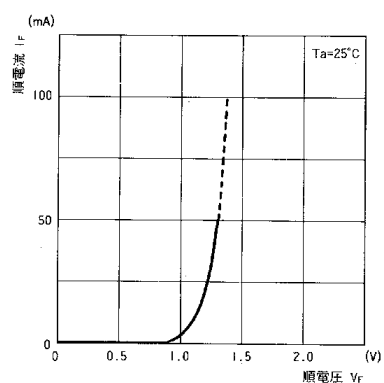
ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS

Item		Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
入 力 Input	順 電 圧 Forward voltage	V _F	I _F =30mA		1.2	1.5	V
	逆 電 流 Reverse current	I _R	V _R =5V			10	μA
	端 子 間 容 量 Capacitance	C _t	V=0, f=1KHz		25		pF
	ピーク発光波長 Peak wavelength	λ _p			940		nm
出 力 Output	暗 電 流 Collector dark current	I _{CEO}	V _{CE} =10V			0.1	μA
	光 電 流 Light current	I _L	V _{CE} =5V, I _F =20mA	0.7		14	mA
	コレクタ・エミッタ間飽和電圧 C-E saturation voltage	V _{CE(sat)}	I _F =20mA, I _C =0.1mA			0.4	V
応答時間 Switching speeds	立 上 り 時 間 Rise time	t _r	V _{CC} =10V I _C =0.5mA R _L =100Ω		10		μsec.
	立 下 り 時 間 Fall time	t _f			15		μsec.

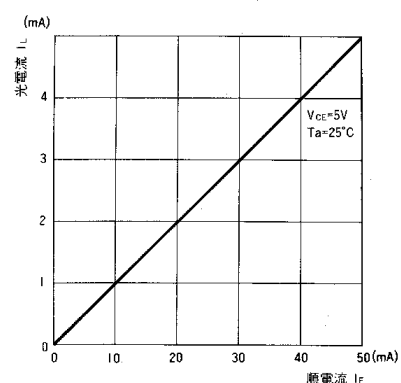
■許容コレクタ損失/周囲温度 P_c/T_a



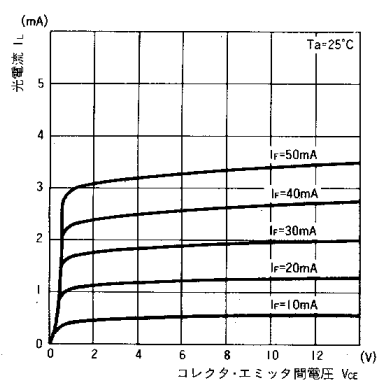
■順電流/順電圧特性 I_F/V_F



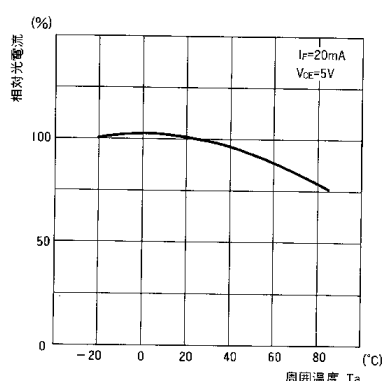
■光電流/順電流特性 I_L/I_F



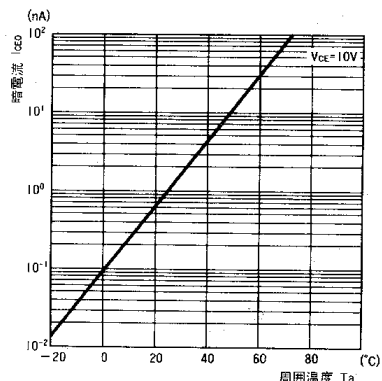
■光電流/コレクタ・エミッタ間電圧特性 I_L/V_{CE}



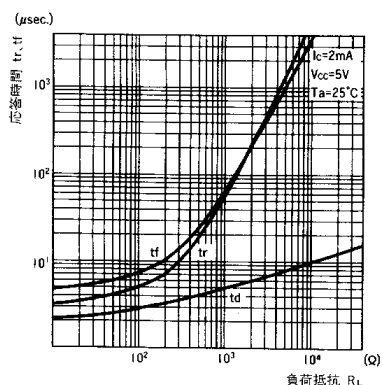
■相対光電流/周囲温度特性 I_L/T_a



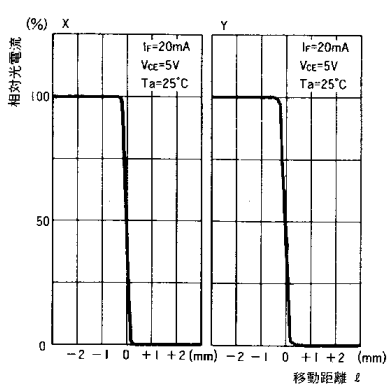
■暗電流/周囲温度特性 I_{CE0}/T_a



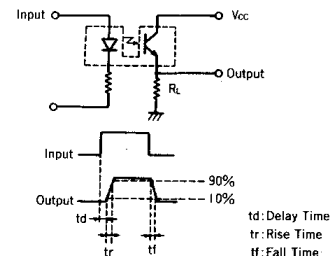
■応答時間/負荷抵抗特性 $t_r, t_f/R_L$ *1



■位置検出特性 *2



*1 応答時間測定条件



*2 位置検出特性測定方法

